

Г АВЛ.431432.073

Перв. примен.
Г АВЛ.431268.021

Справ. №

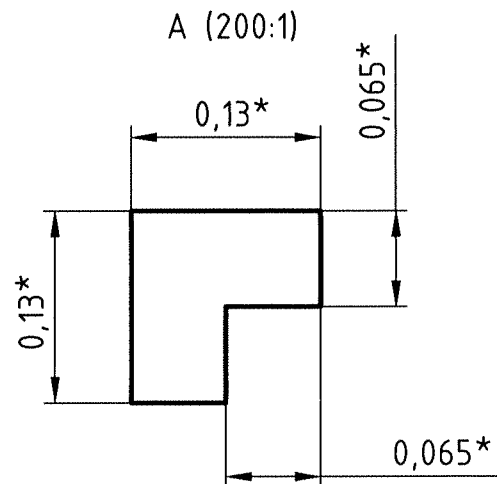
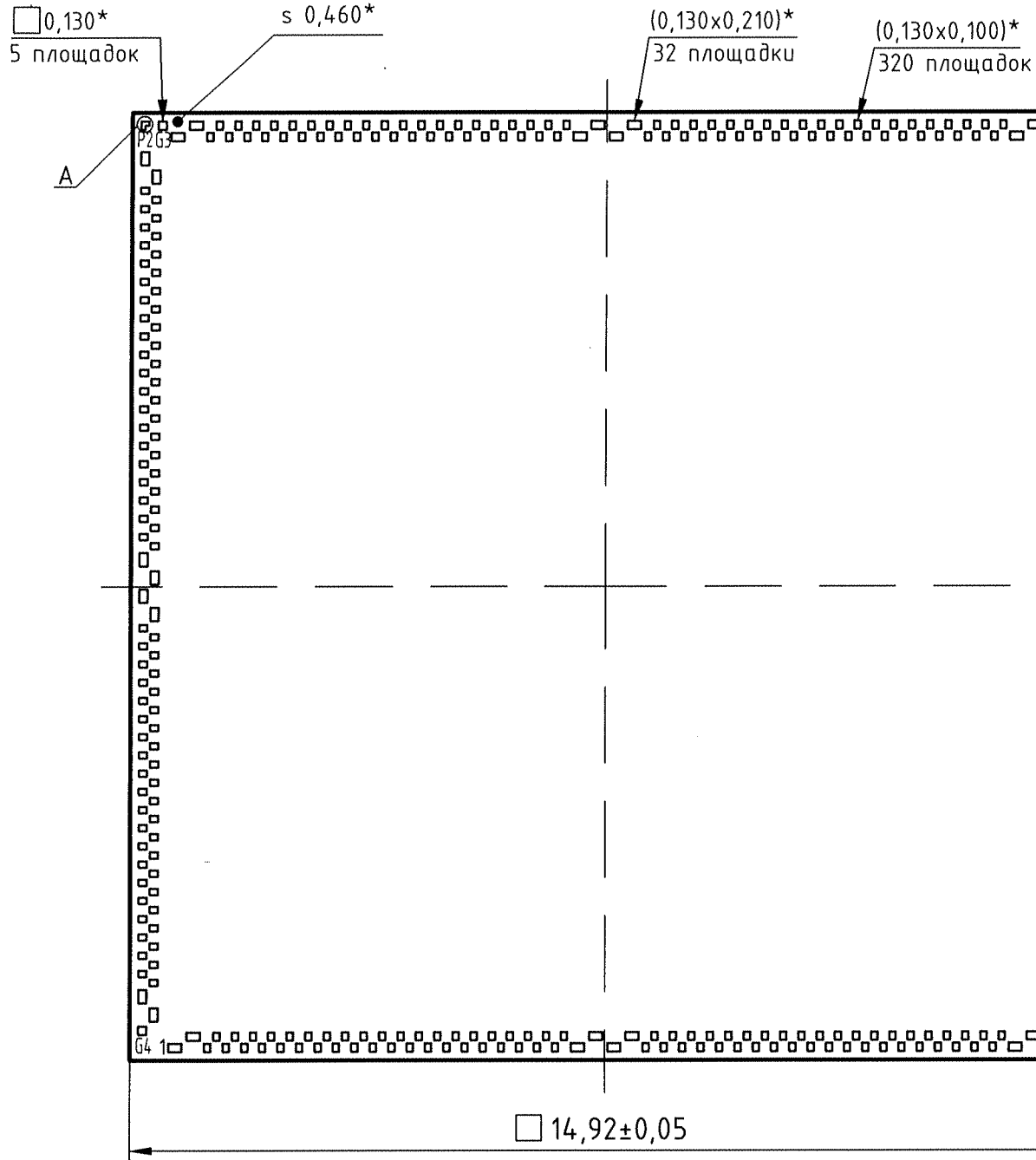
Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



- *Размер для справок.
- Кристалл изготавливается ПАО "МИКРОН" по технологии КМОП КНИ 0,25 мкм.
- Кристалл должен соответствовать ДВУК.431419.035ТУ.
- Координаты центров контактных площадок кристалла приведены в таблице 1 на листе 1 и в таблице 2 на листе 2. Началом отсчета является точка пересечения осей симметрии кристаллов.
- Контактные площадки показаны условно. Назначение контактных площадок приведено в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.
- Размер кристаллов указан после разделения пластины.
- Нумерация выводов против часовой стрелки. Первый вывод обозначен цифрой "1" в верхнем слое металлизации. Обозначения выводов P1, P2 и G1 - G4 показаны условно.

Таблица 1 - Координаты центров контактных площадок P1, P2, G1, G2, G3, G4 кристалла, мкм

№ контактной площадки	P1	P2	G1	G2	G3	G4
Координата X	7257,28	-7257,28	6984,64	7257,28	-6984,64	-7257,28
Координата Y	-7257,28	7257,28	-7257,28	6984,64	7257,28	-6984,64

Г АВЛ.431432.073								
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>[Signature]</i>	29.12.19	Кристалл микросхемы интегральной 5529TP10H4	Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		A	0,1г	10:1
Разраб.	Астахова	<i>[Signature]</i>	13.11.19			Лист 1	Листов 2	
Пров.	Тикашкин	<i>[Signature]</i>	13.11.19					
512 ВП	Чириченко	<i>[Signature]</i>	5.12.19					
Н. контр	Казаков	<i>[Signature]</i>	27.11.19					
Утв.	Денисов	<i>[Signature]</i>	13.11.19					

